

บทที่ 1

บทนำ

1.1 บทนำ

แก้วเซรามิกคือแก้วที่ผ่านกระบวนการทางความร้อนเพื่อช่วยทำให้เกิดผลลัพธ์ในเนื้อแก้วโดยใช้กระบวนการทางความร้อนให้การควบคุมกระบวนการตกผลึก ปริมาณ ขนาด และรูปร่างของผลึกได้ แก้วเซรามิกมีลักษณะ โครงสร้างภายในแบบหลาภผลึก (polycrystalline) และผลึกที่ได้มีขนาดเล็กในระดับนาโนเมตร จากลักษณะดังกล่าวทำให้แก้วเซรามิกมีความแข็งแรงกว่าแก้วปกติ จึงสามารถนำไปใช้งานเป็นภาชนะและกระจกที่มีความแข็งแรงสูงหรือทนความร้อนสูง ในปัจจุบัน แก้วเซรามิกขึ้นรูปสมบัติทางไฟฟ้าที่น่าสนใจ เนื่องจากปริมาณของรูพรุนของแก้วที่น้อยทำให้ค่าการสูญเสียทางไฟฟ้าที่ต่ำลงและมีค่าทางไฟฟ้าที่ดี โดยยังคงความโปร่งใสไว้ได้ ทำให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานทางด้านอุปกรณ์เชิงแสงต่างๆ เช่น สวิตช์แสง อุปกรณ์ทางด้านไมโครเวฟ อุปกรณ์เชิงแสงแบบไม่เป็นเส้นตรง เป็นต้น นักวิทยาศาสตร์จำนวนไม่น้อยที่สนใจศึกษาแก้วเซรามิกโดยมีความพยายามพัฒนาคุณสมบัติทางด้านไฟฟ้าและคุณสมบัติเชิงแสง โดยการเลือกปัจจัยผลึกของสารเฟอร์โรอิเล็กทริกชนิดต่างๆ ลงในเนื้อแก้ว อาทิ ลิเทียมไนโตรเบต (LiNbO_3) โพแทสเซียมไนโตรเบต (KNbO_3) และอื่นๆ อีกมากนัก เกิดเป็นแก้วเซรามิกเฟอร์โรอิเล็กทริก ทำให้แก้วเซรามิกเป็นวัสดุชนิดหนึ่งที่มีความน่าสนใจที่จะนำไปศึกษาเพื่อประยุกต์ใช้งานทางด้านไฟฟ้าเชิงแสง

วัสดุเฟอร์โรอิเล็กทริกเป็นวัสดุที่แสดงพฤติกรรมที่มีการตอบสนองของโพลาไรเซชั่นไฟฟ้า คือสามารถกลับพิศทาง ได้เมื่อมีการให้สนามไฟฟ้าเข้าไป เพราะฉะนั้นวัสดุเฟอร์โรอิเล็กทริกจึงเหมาะสมกับการประยุกต์ใช้งานทางด้านต่างๆ เช่น อุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์เชิงแสง (optoelectronic) และอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร เช่น โมดูลेटอร์ (Modulators), ตัวเก็บประจุและอื่นๆ อีกมาก [7-9] อย่างไรก็ตามวัสดุเฟอร์โรอิเล็กทริกที่นิยมใช้ก็คือวัสดุที่มีผลึกเดียว (single crystal) วัสดุเฟอร์โรอิเล็กทริกที่มีผลึกเดียวนี้จะมีกระบวนการผลิตที่ต้องใช้ความชำนาญสูงและระยะเวลาในการผลิตที่นาน เนื่องจากกระบวนการผลิตที่มีความซับซ้อน จึงทำให้มีราคาที่แพงขึ้นตาม เมื่อไม่นานมา นี้นักวิทยาศาสตร์สามารถผลิตวัสดุเฟอร์โรอิเล็กทริกหลาภชนิดที่มีความโปร่งแสงได้สำเร็จโดยสามารถปัจจุบลิกที่มีขนาดนาโนเมตร ไว้ภายในเนื้อแก้วได้ เพียงอาศัยกระบวนการทางความร้อน

และแก้วเบสที่มีความเหมาสม โดยการนำไปใช้งานในปัจจุบันได้แก่ อุปกรณ์แสดงผล (display device) สวิตช์ทางแสง (optical switch) และตัวแยกทางแสง (optical isolator) เป็นต้น

ในงานวิจัยนี้สามารถเตรียมแก้วเซรามิกได้จากการอินคอร์ปอเรชั่น (incorporation) โดยเริ่มจากการเตรียมสารตั้งต้นโพแทสเซียมโซเดียมในโอบেตด้วยวิธีการผสมออกไซด์ (mixed oxide method) แล้วจึงนำสารตั้งต้นที่เตรียมได้ไปผสมกับซิลิกา เพื่อสร้างแก้วเซรามิกและปลูกพลีกด้วยความร้อน จากนั้นจึงนำชิ้นงานไปวิเคราะห์องค์ประกอบเฟส โครงสร้างทางจุลภาค ขนาดของผลึก ทดสอบสมบัติต่างๆ อาทิ กายภาพ ความร้อน ไฟฟ้า และเชิงแสงต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา

- เพื่อศึกษาและพัฒนาระบวนการผลิตแก้วเซรามิกเฟอร์โอดิเล็กทริก ไร้สารตะกั่วในระบบโพแทสเซียมโซเดียมในโอบেตโดยวิธีการอินคอร์ปอเรชั่น (incorporation)
- เพื่อศึกษาเงื่อนไขในการเตรียมแก้วเซรามิกที่เหมาะสม และปัจจัยที่มีผลต่อชนิด ขนาด และปริมาณผลึกของแก้วเซรามิกที่เตรียมได้ถึงอิทธิพลของตัวแปรในกระบวนการวิธีทางความร้อน (heat treatment) เช่น อุณหภูมิที่ใช้ อัตราการขึ้นลงของอุณหภูมิ และระยะเวลาต่อการตกผลึกในแก้ว
- เพื่อศึกษาผลของขนาดและรูปร่างของผลึกในแก้วเซรามิก ไร้สารตะกั่วที่เตรียมได้ต่อสมบัติต่างๆ เช่น สมบัติทางกายภาพ ไฟฟ้า และทางแสง เป็นต้น
- เพื่อศึกษาสมบัติทางเฟอร์โอดิเล็กทริก และ ไดอิเล็กทริกของแก้วเซรามิก ไร้สารตะกั่วที่เตรียมได้ เพื่อการนำแก้วเซรามิก ไร้สารตะกั่วที่เตรียมได้ไปประยุกต์ด้านไฟฟ้าเชิงแสง

1.3 ประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษา เชิงทฤษฎีและ/หรือเชิงประยุกต์

- ทราบวิธีการประดิษฐ์แก้วเซรามิกเฟอร์โอดิเล็กทริก ไร้สารตะกั่ว โพแทสเซียมโซเดียมใน-โอบেตโดยวิธีการอินคอร์ปอเรชั่น (incorporation)
- ทราบอิทธิพลของตัวแปรต่างๆ เช่น อุณหภูมิที่ใช้ในกระบวนการทางความร้อน ขนาด และรูปร่างของผลึก ต่อสมบัติต่างๆ ของแก้วเซรามิกที่เตรียมได้ ทั้งกายภาพ ทางแสง และทางไฟฟ้าได้
- สามารถพัฒนาวัสดุเฟอร์โอดิเล็กทริก และ ไดอิเล็กทริกที่ปราศจากออกไซด์ของตะกั่วให้มีสมบัติที่ดีขึ้นได้